О природе энергетической щели додекаборида иттербия YbB₁₂

© Т.С. Альтшулер, М.С. Бреслер*

Физико-технический институт им. Е.К. Завойского Российской академии наук, 420029 Казань, Россия * Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе Российской академии наук,

194021 Санкт-Петербург, Россия

E-mail: tatiana@dionis.kfti.kcn.ru

Методом ЭПР исследован кондо-изолятор YbB₁₂. Установлено существование электронной щели в энергетическом спектре YbB₁₂ шириной $2\Delta \approx 12$ meV. Экспериментальные данные интерпретированы в рамках модели экситонного диэлектрика. Определена температурная зависимость энергетической щели: $\Delta(T) = 72$ K при абсолютном нуле температур и исчезает при температуре ~ 115 K.

Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (грант № 00-02-16080).

Додекаборид иттербия — YbB₁₂ — материал с флуктуирующей валентностью, в спектре электронных возбуждений которого наблюдается щель шириной 10-25 meV. Несмотря на широкое использование экспериментальных методов (см., например, [1-5]), природа образования электронной щели в кондо-изоляторах остается до сих пор непонятной. Согласно экспериментальным данным, необычные низкотемпературные свойства кондо-изолятора трактовались в основном в рамках модели f - d гибридизационной щели, частично перенормированной корреляционными эффектами [5]. Однако эта модель не может объяснить некоторые тонкие детали поведения этого материала при низких температурах и поэтому необходимо привлечение более совершенных теорий (экситонно-поляронной модели, развитой в [6] и [7], и модели вигнеровской кристаллизации [8]). В данной работе для исследования додекаборида иттербия был применен метод ЭПР, который оказался весьма полезным при изучении электронной щели в SmB₆ классическом кондо-изоляторе [9].

1. Эксперимент

Измерения ЭПР были выполнены на порошкообразных образцах додекаборида иттербия, легированного гадолинием Gd^{3+} с концентрацией c = 0.1, 0.5 и 1 at.%: Yb_{0.999}Gd_{0.001}B₁₂, Yb_{0.995}Gd_{0.005}B₁₂, Yb_{0.99}Gd_{0.01}B₁₂ и додекаборида лютеция, легированного 1 at.% Gd³⁺: Lu_{0.99}Gd_{0.01}B₁₂. Соединение YbB₁₂ синтезировалось в индукционной печи в вакууме при 1700 К путем барометрического восстановления оксида Yb₂O₃. Затем оно расплавлялось в дуговой печи и растворялось в азотной кислоте, чтобы удалить остатки примеси YbB₆. Однофазный образец в виде черного порошка проверялся с помощью рентгеновского дифракционного анализа. Аналогичным образом приготавливался образец додекаборида лютеция. Размер отдельных зерен в порошке составлял 10-20 µm и был меньше толщины скин-слоя полупроводника YbB12 и металла LuB12. Для лучшего проникновения электромагнитного поля в зерна порошки смешивались с расплавленным парафином.

Измерения были выполнены на частоте $\nu = 9.4 \, \text{GHz}$ в температурном диапазоне $1.7-80 \, \text{K}$.

Во всех образцах наблюдался интенсивный сигнал ЭПР от иона Gd^{3+} . На рис. 1 приведена температурная зависимость ширины линии $\delta H(T)$ для полупроводника $\mathrm{Yb}_{0.99}\mathrm{Gd}_{0.01}\mathrm{B}_{12}$ и $\mathrm{Lu}_{0.99}\mathrm{Gd}_{0.01}\mathrm{B}_{12}$, обладающего металлической проводимостью. В $\mathrm{Lu}_{0.99}\mathrm{Gd}_{0.01}\mathrm{B}_{12}$ наблюдался сигнал ЭПР от ионов Gd^{3+} с типичной для металлов линейной зависимостью ширины линии от температуры $\delta H = a + bT$. Температурный наклон $b = \delta H/\delta T = 1.25 \,\mathrm{Oe/K}$. В $\mathrm{Yb}_{0.99}\mathrm{Gd}_{0.01}\mathrm{B}_{12}$ зависимость более сложная: ниже 10 К наблюдается небольшое уширение линии, тогда как выше 20 К ширина линии ЭПР увеличивается почти экспоненциально, при 50 К выходит на насыщение, интенсивность сигнала ЭПР падает и выше 80 К ширину линии практически невозможно определить.

На образцах с меньшей концентрацией Gd (рис. 2) сигнал ЭПР наблюдался до 17 (c = 0.1 at.%) и до 25 K (c = 0.5 at.%). Остаточная ширина линии (δH при



Рис. 1. Температурная зависимость ширины линии ЭПР на ионах Gd^{3+} в додекаборидах иттербия YbB_{12} (1) и лютеция LuB_{12} (2). Расчет — сплошная линия. Концентрация Gd^{3+} составляет 1 at.%.



Рис. 2. Температурная зависимость ширины линии ЭПР на ионах Gd^{3+} в додекабориде иттербия YbB_{12} при низких температурах. Концентрация Gd^{3+} 0.1 (1), 0.5 (2) и 1 at.% (3).



Рис. 3. Температурная зависимость *g*-фактора ионов Gd^{3+} в додекаборидах иттербия YbB_{12} и лютеция LuB_{12} . Обозначения на рисунке.



Рис. 4. Температурная зависимость энергетической щели $\Delta(T)$ в додекабориде иттербия YbB₁₂.

T = 0) увеличивается с концентрацией Gd, однако с повышением температуры до 13–14 K эта концентрационная зависимость пропадает. Значения δH для всех трех концентраций Gd ложатся на одну кривую. Такое поведение означает, что при T > 14-15 K ширина линии определяется чисто релаксационными процессами. При 13–14 K в образцах наблюдается ярко выраженная особенность ширины линии δH (выступ, или kink).

На рис. 3 представлена температурная зависимость *g*-фактора ионов Gd³⁺ в LuB₁₂ и в YbB₁₂. Гадолиний Gd³⁺ обладает чисто спиновым парамагнетизмом (основное состояние $4f^7$, ${}^8S_{7/2}$), поэтому его *g*-фактор близок к 2.00. В "корринговском", металлическом LuB₁₂ действительно наблюдается близкий к 2.00 *g*-фактор: $g_{Lu} = 1.990 \pm 0.005$.

В YbB₁₂ поведение *g*-фактора гадолиния при низких температурах (< 12 K) обнаруживает полную корреляцию с поведением ширины линии, уширение линии сопровождается ростом *g*-фактора. Такая корреляция объясняется ферромагнитным упорядочением ионов Gd.

При T > 12 K g-фактор не зависит от температуры и равен 1.945 \pm 0.015. Видно, что в YbB₁₂ наблюдается довольно сильный сдвиг g-фактора ($\delta g_{Yb} = -0.045$) по сравнению с δg в обычных металлах (для Lu_{0.99}Gd_{0.01}B₁₂ $\delta g_{Lu} = -0.01$). Хорошо известно, что в кондо-изоляторах плотность состояний на уровне Ферми $N(\varepsilon_F)$ из-за sf-гибридизации значительно выше, чем в обычных металлах. Поскольку $\delta g \sim N(\varepsilon_F)$, такой сдвиг является указанием на существование флуктуирующей валентности в YbB₁₂.

Действительно, наблюдается тесная корреляция между средней валентностью редкоземельного иона и сдвигом g-фактора в кондо-диэлектриках: средняя валентность Yb в YbB₁₂ равна 2.90, а сдвиг g-фактора $\delta g = -0.045$, тогда как средняя валентность Sm в SmB₆ равна 2.65 при сдвиге g-фактора $\delta g = -0.080$ [9]. Кроме этого факта о существовании флуктуирующей валентности в додекабориде иттербия свидетельствует "полупроводниковый" характер температурной зависимости $\delta H(T)$. Последняя подобна зависимости, наблюдавшейся в SmB₆ — классическом объекте кондо-изолятора [9], и резко отличается от линейной, характерной для металлов зависимости $\delta H(T)$ в додекаборидах других редких земель.

2. Обсуждение результатов

Додекаборид иттербия, YbB₁₂, в отличие от изоструктурного ему додекаборида лютеция LuB₁₂ с металлической проводимостью является кубическим кондоизолятором с узкой щелью (кондо-полупроводником). Температурная зависимость ширины линий ЭПР ионов Gd³⁺ в этих двух соединениях резко отличается (рис. 1). Если в LuB₁₂ мы видим линейную зависимость $\delta H(T)$ с относительно малой корринговской релаксацией, характерную для металлов, то экспоненциальное уширение Существуют однако различные точки зрения на происхождение щели. Щель связывалась с sf-гибридизацией [5], с вигнеровской кристаллизацией [8] и экситонным спариванием d-электронов с f-дырками [9,10]. Есть существенное расхождение в результатах теории при конечных температурах. Так, гибридизационная щель не меняется с температурой, а экситонная возникает как коллективный эффект и исчезает при температурах порядка самой щели. Расчеты в модели sf-гибридизации с постоянной щелью не привели к хорошему описанию наших экспериментальных данных.

Теория основного состояния и необычных свойств YbB_{12} не разработана с такой степенью детальности как для SmB_6 , поэтому будем опираться на теоретические работы, относящиеся к гексабориду самария.

По-видимому, лучше всего необычные свойства SmB₆, включая аномалии фононного спектра [1] и дисперсию магнитных возбуждений, исследуемую методом неупругого рассеяния нейтронов [12], описываются экситонполяронной моделью Кикоина и Мищенко [6]. Модель заключается в представлении о том, что основное состояние системы представляет собой суперпозицию состояния f^6 , отвечающего иону Sm²⁺, с состоянием $f^{5}p$, отвечающим экситону промежуточной связи, в котором дырка находится в f-оболочке иона самария (Sm³⁺), а электрон — на орбите, представляющей собой линейную комбинацию из р-состояний окружающих самарий атомов бора (в первой координационной сфере). Экситон находится в синглетном (т.е. немагнитном) состоянии. Корреляция в состоянии экситонов на различных узлах устанавливается, по-видимому, за счет взаимодействия экситонов, не возникающего в приближении среднего поля. Так образуется макроскопически когерентное состояние. Образование экситонов приводит к появлению щели в электронном спектре. Поскольку флуктуации валентности происходят с "фононными" частотами $10^{12} - 10^{13}$ Hz, неудивительно, что они оказываются "сцепленными" с колебаниями решетки. При этом происходит смягчение фононных мод и перенормировка электронных (экситонных) состояний: возникает смешанное экситон-поляронное состояние. С фононными модами смешиваются как зарядовые возбуждения (полярон), так и спиновые возбуждения (спин-полярон). Источником последних и является наблюдавшийся в SmB₆ эффект Яна-Теллера [13,14] (см. также [15]).

К сожалению, в модели Кикоина-Мищенко не рассчитывалась скорость спиновой релаксации в кондоизоляторе. Поэтому мы были вынуждены интерпретировать свои результаты в рамках расчета, выполненного в [9] Халиуллиным и Хомским, которые построили модель экситонного диэлектрика с экситонами большого радиуса (Мотта–Ванье), состоящими из d-электрона и f-дырки. Расчеты Халиуллина–Хомского следовали в общих чертах модели парных корреляций электронов в сверхпроводниках. Естественно, как и в теории сверхпроводимости, возникает зависящая от температуры щель в спектре экситонного диэлектрика; сравнение с экспериментом позволяет определить эту зависимость. Для скорости спиновой релаксации в работе [9] была получена формула

$$\begin{split} T_2^{-1} &= 2\pi T f(\Delta) \left(b_d^2 + b_f^2 \right) \{ 1 + \alpha [1 - f(\Delta)] (\Delta/2T) \ln 2\Delta \tau \}, \\ f(\Delta) &= [1 + \exp(\Delta/T)]^{-1}, \\ b_i &= J_i N_i, \quad \alpha = (b_d + b_f)^2 / (b_d^2 + b_f^2), \end{split}$$

 $\Delta = \Delta(T)$ — экситонная щель, J_d, J_f — обменные интегралы взаимодействия Gd с *d*-электроном и *f*-дыркой, N_d, N_f — плотности состояний соответствующих зон на уровне Ферми в YbB₁₂, τ — время релаксации импульса (потери корреляций).

Мы получили удовлетворительное описание экспериментальных значений T_2^{-1} (см. расчетную кривую на рис. 1) при следующих значениях параметров:

$$b_d = -0.701 \cdot 10^{-2}, \ \ b_f = -1.902 \cdot 10^{-2},$$

 $lpha = 1.65, \ \ au = 1.00 \, {
m K}^{-1}.$

Хотя b_d , b_f и τ являются независимыми параметрами при подгонке, они должны удовлетворять и остальным экспериментальным результатам. Известно, что πb_d^2 порядка температурного наклона ширины линии Gd в LuB₁₂: $\pi b_d^2 = 1.54 \text{ Oe/K}, \ \delta H / \delta T(\exp .) = 1.25 \text{ Oe/K}.$ Сдвиг g-фактора в кондо-диэлектриках пропорционален сумме b_d и b_f

$$\delta g = b_d + \gamma b_f, \quad \gamma = [4/3J(J+1)]^{1/2};$$

 $\delta g = -0.09, \quad \delta g_{\exp} = -0.045.$

Как видно из сравнения, получено неплохое согласие с экспериметом. Возможно, что разница между влиянием на скорость релаксации T_2^{-1} спинов Gd³⁺ экситонов промежуточной связи и экситонов Мотта-Ванье не вносит кардинальных изменений при сравнении эксперимента с теорией. На рис. 4 представлена полученная нами температурная зависимость щели. Видно, что щель $\Delta(T)$ при самых низких температурах равна 72 К, почти не меняется до 40 К, а затем уменьшается и, возможно, исчезает при 115 К. Поскольку щель равна 2 $\Delta = 140$ К, она примерно такого же порядка, как и $T_{\rm cr} \sim 115 \, {\rm K}$ в согласии с ожиданиями теории. Наши результаты $(2\Delta = 12 \text{ meV})$ следует сравнить с экспериментальными данными по исследованию фотоэлектронной эмиссии [4] и оптической проводимости [3] в YbB₁₂. В первой из этих работ была обнаружена щель в спектре с энергией 10 meV, которая возникала (при подходе со стороны высоких температур) ниже \sim 75 K. Во второй работе щель шириной 25 meV возникала также при температуре ниже 70 K.

Таким образом, наши результаты вполне удовлетворительно согласуются с данными, полученными другими методами.

Обращает на себя внимание выступ (kink) на температурной зависимости ширины линии ЭПР при низких температурах (рис. 2). Этот выступ наблюдается для двух уровней легирования гадолинием образцов YbB₁₂. Он не виден при 1% Gd, как упоминалось выше, изза ферромагнитного упорядочения. Интересно отметить, что такой же выступ наблюдался нами и в SmB₆ при тех же температурах и также не зависел от концентрации примеси. По-видимому, возрастание ширины линии при температуре 13-14К связано с наличием плотности электронных состояний внутри корреляционной щели, что представляет значительный интерес. Наиболее простое объяснение — наличие примесных состояний внутри щели, что, однако, плохо согласуется с отсутствием зависимости наших результатов от концентрации легирующей примеси — гадолиния. Более интересным является предположение о связи этой плотности состояний с особенностями основного состояния системы, например, с образованием связанного полярона, существование которого рассматривается в работе Кёрноу и Кикоина [7]. Во всяком случае, имеющихся экспериментальных данных недостаточно, чтобы делать какие-то окончательные выводы, и вопрос о природе наблюдавшихся дополнительных возбуждений подлежит более подробному исследованию.

Исследование, проведенное нами методом ЭПР, показало, что энергетическая щель в кондо-диэлектриках: YbB₁₂ и ранее в SmB₆ [9] не является одночастичной, т. е. вызванной простой *s*-*f*-гибридизацией, а имеет коллективную природу. К сожалению, из ЭПР-измерений невозможно сделать выбор между моделями экситонного диэлектрика и вигнеровской кристаллизации. Можно однако утверждать, что щель удовлетворительным образом описывается с помощью модели экситонного диэлектрика, и если принять во внимание отсутствие экспериментальных дынных, характерных для вигнеровской кристаллизации, то модель экситонного диэлектрика кажется нам более предпочтительной.

Список литературы

- T. Yoshino, T. Suzuki, Y. Bando, N. Shimizu, H.V. Lohneysen, F. Iga, G. Nakamoto, T. Takabatake. J. Magn. Magn. Mater. 177–181, 277 (1998).
- [2] F. Iga, N. Shimizu, T. Takabatake. J. Magn. Magn, Mater. 177– 181, 337 (1998).
- [3] H. Okamura, S. Kimura, H. Shinozaki, T. Nanba, F. Iga, N. Shimizu, T. Takabatake. Phys. Rev. B58, R7496 (1998);
 H. Okamura, N. Shimizu, T. Takabatake, T. Nanba, F. Iga, H. Shinozaki, S. Kimura. Physica B259–261, 317 (1999).

- [4] T. Suzaki, Y. Takeda, M. Arita, K. Mamiya, A. Fujimori, K. Shimada, H. Namatame, M. Taniguchi, N. Shimizu, F. Iga, T. Takabatake. Phys. Rev. Lett. 82, 992 (1999).
- [5] G. Aeppli, Z. Fisk. Comments Condens. Matter Phys. 16, 155 (1992).
- [6] К.А. Кикоин, А.С. Мищенко. ЖЭТФ 104, 3810 (1993);
 К.А. Kikoin, A.S. Mishchenko. J. Phys.: Condens. Matter 7, 307 (1995).
- [7] S. Curnoe, K.A. Kikoin. Phys. Rev. B61, 15714 (2000).
- [8] T. Kasuya. J. Phys. Soc. Japan 65, 2548 (1996).
- [9] Т.С. Альтшулер, Г.Г. Халиуллин, Д.И. Хомский. ЖЭТФ 90, 2104 (1986).
- [10] Т.С. Альтшулер, В.Н. Миронов, Г.Г. Халиуллин, Д.И. Хомский. Письма в ЖЭТФ 40, 28 (1984).
- [11] P.A. Alekseev, A.S. Ivanov, B. Dorner. Europhys. Lett. 10, 457 (1989).
- [12] P.A. Alekseev, J.-M. Mignot, J. Rossat-Mignot, V.N. Laazukov, I.P. Sadikov, E.S. Konovalova, Yu.B. Paderno. J. Phys. Condens. Matter 7, 289 (1995).
- [13] H. Sturm, B. Elschner, K.H. Hoeck. Phys. Rev. Lett. 54, 1291 (1985); C. Weber, E. Sigmund, M. Wagner. Phys. Rev. Lett. 55, 1645 (1985).
- [14] Т.С. Альтшулер, М.С. Бреслер. ЖЭТФ 115, 1860 (1999).
- [15] T.P. Nyhus, S.L. Cooper, Z. Fisk, J. Sarrao. Phys. Rev. B55, 12488 (1997).